

# Одиночные MOSFET транзисторы

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tax@nt-rt.ru](mailto:tax@nt-rt.ru) || сайт: <https://texas.nt-rt.ru>



#### CSD13202Q2

Полевой транзистор, N-канальный, 12 В, 76 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON6  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 22А  
Сопротивление открытого канала: 9.3 мОм  
Мощность макс.: 2.7Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В  
Заряд затвора: 6.6нКл  
Входная емкость: 997пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD13380F3

Производитель: Texas Instruments

#### CSD13381F4

Транзистор полевой N-канальный 12В 2.1А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 2.1А  
Сопротивление открытого канала: 180 мОм  
Мощность макс.: 500мВт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.:  
1.1В Заряд затвора: 1.4нКл  
Входная емкость: 200пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD13381F4T

Транзистор полевой N-канальный 12В 2.1А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 2.1А  
Сопротивление открытого канала: 180 мОм  
Мощность макс.: 500мВт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.:  
1.1В Заряд затвора: 1.4нКл  
Входная емкость: 200пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD15380F3

Trans MOSFETN-CH 20V 0.5A 3-Pin PicoStar T/R

Производитель: Texas Instruments

CSD15380F3T

Полевой транзистор N-канальный 20В 0.5А 3-Pin PicoStar лента на катушке

Производитель: Texas Instruments

Напряжение исток-сток макс.: 20В

Ток стока макс.: 0.5А

Тип транзистора: N-канал

CSD16301Q2

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON6

Напряжение исток-сток макс.: 25В

Ток стока макс.: 5А

Сопротивление открытого канала: 24 мОм

Мощность макс.: 2.3Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.55В

Заряд затвора: 2.8нКл

Входная емкость: 340пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD16321Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

CSD16322Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 25В

Ток стока макс.: 21А

Сопротивление открытого канала: 5 мОм

Мощность макс.: 3.1Вт

Тип транзистора: N-канал

Пороговое напряжение включения макс.: 1.4В

Заряд затвора: 9.7нКл

Входная емкость: 1365пФ

Тип монтажа: Surface Mount

### CSD16323Q3

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON-8

### CSD16327Q3T

Полевой транзистор N-канальный 25В 21А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 60А  
Сопротивление открытого канала: 4 мОм  
Мощность макс.: 3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.4В  
Заряд затвора: 8.4нКл  
Входная емкость: 1300пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

### CSD16340Q3

Транзистор полевой N-канальный 25В 60А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 21А  
Сопротивление открытого канала: 4.5 мОм  
Мощность макс.: 3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В  
Заряд затвора: 9.2нКл  
Входная емкость: 1350пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

### CSD16340Q3T

Полевой транзистор N-канальный 25В 60А 8VSON  
Производитель: Texas Instruments

### CSD16401Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 100 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 25В

Ток стока макс.: 38А  
Сопротивление открытого канала: 1.6 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В  
Заряд затвора: 29нКл  
Входная емкость: 4100пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD16403Q5A

Транзистор полевой N-канальный 25В 100А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 28А  
Сопротивление открытого канала: 2.8 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В  
Заряд затвора: 18нКл  
Входная емкость: 2660пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD16404Q5A

Транзистор полевой N-канальный 25В 81А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 21А  
Сопротивление открытого канала: 5.1 мОм  
Мощность макс.: 3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.1В  
Заряд затвора: 8.5нКл  
Входная емкость: 1220пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

Новинка

#### CSD16406Q3

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 25В 60А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON-8  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 19А  
Сопротивление открытого канала: 5.3 мОм  
Мощность макс.: 2.7Вт

Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.2В  
Заряд затвора: 8.1нКл  
Входная емкость: 1100пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD16407Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 100 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 31А  
Сопротивление открытого канала: 2.4 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В  
Заряд затвора: 18нКл  
Входная емкость: 2660пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD16409Q3

Транзистор полевой N-канальный 25В 60А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 15А  
Сопротивление открытого канала: 8.2 мОм  
Мощность макс.: 2.6Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 5.6нКл  
Входная емкость: 800пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD16411Q3

Полевой транзистор, N-канальный, 25 В, 56 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON (3.3x3.3)  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 14А  
Сопротивление открытого канала: 10 мОм  
Мощность макс.: 2.7Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 3.8нКл

Входная емкость: 570пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD16413Q5A

Транзистор полевой N-канальный 25В 100А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 25В  
Ток стока макс.: 24А  
Сопротивление открытого канала: 3.9 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В  
Заряд затвора: 11.7нКл  
Входная емкость: 1780пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17301Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 28 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP

#### CSD17302Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 87 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 16А  
Сопротивление открытого канала: 7.9 мОм  
Мощность макс.: 3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.7В  
Заряд затвора: 7нКл  
Входная емкость: 950пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17303Q5

MOSFETN-CH 30V 100A 8SON  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON-8

#### CSD17306Q5A

Транзистор полевой N-канальный 30В 100А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 24А  
Сопротивление открытого канала: 3.7 мОм  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.6В  
Заряд затвора: 15.3нКл  
Входная емкость: 2170пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17307Q5A

Транзистор полевой N-канальный 30В 73А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 14А  
Сопротивление открытого канала: 10.5 мОм  
Мощность макс.: 3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В  
Заряд затвора: 5.2нКл  
Входная емкость: 700пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17308Q3

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 47А 2.7Вт  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 47А  
Мощность макс.: 2.7Вт  
Тип транзистора: N-канальный

#### CSD17308Q3T

Транзистор полевой N-канальный 30В VSON 8  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 13А(Тa), 47А(Тc)  
Сопротивление открытого канала: 10.3 мОм @ 10А, 8В  
Мощность макс.: 2.7Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Standard  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В @ 250 μА  
Заряд затвора: 5.1нКл @ 4.5В  
Входная емкость: 700пФ @ 15В  
Тип монтажа: Surface Mount

### CSD17309Q3

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 60 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 20А

Сопротивление открытого канала: 5.4 мОм

Мощность макс.: 2.8Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.7В

Заряд затвора: 10нКл

Входная емкость: 1440пФ

Тип монтажа: Surface Mount

Новинка

### CSD17310Q5A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 21А/100А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: VSON8-HR

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 21А/100А

Тип транзистора: N-канальный

Тип монтажа: Surface Mount

### CSD17312Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 38А

Сопротивление открытого канала: 1.5 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.5В

Заряд затвора: 36нКл

Входная емкость: 5240пФ

Тип монтажа: Surface Mount

### CSD17313Q2-Q1

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 5 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON6

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 5А  
Сопrotивление открытого канала: 30 мОм  
Мощность макс.: 2.3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В  
Заряд затвора: 2.7нКл  
Входная емкость: 340пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17313Q2-Q1

Полевой транзистор N-канальный 30В 5А автомобильного применения 6-Pin  
WSON EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments

#### CSD17313Q2Q1

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 5 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON6  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 5А  
Сопrotивление открытого канала: 30 мОм  
Мощность макс.: 2.3Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Automotive, Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В  
Заряд затвора: 2.7нКл  
Входная емкость: 340пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17318Q2

МОП-транзистор  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 25А  
Тип транзистора: N-канальный  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17381F4T

Транзистор полевой N-канальный 30В 3.1А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 3.1А  
Сопrotивление открытого канала: 109 мОм  
Мощность макс.: 500мВт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В  
Заряд затвора: 1.35нКл  
Входная емкость: 195пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17382F4T

Транзистор полевой N-канальный 30В 2.3А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 2.3А  
Тип транзистора: N-канал

#### CSD17483F4

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 1.5 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3

#### CSD17483F4T

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 1.5 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3

#### CSD17484F4T

МОП-транзистор 30V N-Ch FemtoFETМОП-транзистор  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Тип транзистора: N-канальный  
Особенности: FemtoFET  
Одиночные MOSFET транзисторы (98)

#### CSD17506Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 100 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 100А  
Сопротивление открытого канала: 4 мОм  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В  
Заряд затвора: 11нКл  
Входная емкость: 1650пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD17522Q5A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 16А 8-Pin SON EP лента на катушке

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 16А

Тип транзистора: N-канальный

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17552Q3A

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 15 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 15А

Сопротивление открытого канала: 6 мОм

Мощность макс.: 2.6Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В

Заряд затвора: 12нКл

Входная емкость: 2050пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17552Q5A

Транзистор полевой N-канальный 30В 17А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: 8-VSON (5x6)

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 17А

Сопротивление открытого канала: 6.2 мОм

Мощность макс.: 3Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В

Заряд затвора: 12нКл

Входная емкость: 2050пФ

Тип монтажа: Surface Mount

CSD17559Q5

Полевой транзистор, N-канальный, 30 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 30В

Ток стока макс.: 40А

Сопротивление открытого канала: 1.15 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.7В  
Заряд затвора: 51нКл  
Входная емкость: 9200пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17571Q2  
Полевой транзистор N-канальный 30В 22А 6SON  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 6-SON (2x2)

CSD17577Q3AT  
Полевой транзистор N-канальный 30В 35А 8-Pin VSONP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSONP (3x3.15)  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 35А(Та)  
Сопротивление открытого канала: 4.8 мОм @ 16А, 10В  
Мощность макс.: 2.8Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.8В @ 250 μА  
Заряд затвора: 35нКл @ 10В  
Входная емкость: 2310пФ @ 15В  
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17579Q3A  
Транзистор полевой N-канальный 30В 35А QFN  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSONP (3x3.15)  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 20А(Та)  
Сопротивление открытого канала: 10.2 мОм @ 8А, 10В  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.9В @ 250 μА  
Заряд затвора: 15нКл @ 10В  
Входная емкость: 998пФ @ 15В  
Тип монтажа: Surface Mount

CSD17585F5  
Полевой транзистор N-канальный 30В 5.9А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 30В  
Ток стока макс.: 5.9А  
Тип транзистора: N-канал

#### CSD18501Q5A

Транзистор полевой N-канальный 40В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 40В  
Ток стока макс.: 22А  
Сопротивление открытого канала: 3.2 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 50нКл  
Входная емкость: 3840пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18503Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 40 В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 40В  
Ток стока макс.: 19А  
Сопротивление открытого канала: 4.3 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 32нКл  
Входная емкость: 2640пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18504KCS

Транзистор полевой N-канальный 40В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: TO-220  
Напряжение исток-сток макс.: 40В  
Ток стока макс.: 53А  
Сопротивление открытого канала: 7 мОм  
Мощность макс.: 93Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 25нКл  
Входная емкость: 1800пФ  
Тип монтажа: Through Hole

#### CSD18504Q5A

Транзистор полевой N-канальный 40В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 40В  
Ток стока макс.: 15А  
Сопротивление открытого канала: 6.6 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.4В  
Заряд затвора: 19нКл  
Входная емкость: 1656пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18504Q5AT

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 40В 50А 77Вт  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 40В  
Ток стока макс.: 50А  
Мощность макс.: 77Вт  
Тип транзистора: N-канальный

#### CSD18509Q5B

Trans MOSFET N-CH Si 40V 100A 8-Pin VSON-CLIP EPT/R  
Производитель: Texas Instruments

#### CSD18509Q5BT

Полевой транзистор N-канальный 40В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 40В  
Ток стока макс.: 100А  
Сопротивление открытого канала: 1.2 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.:  $\pm 20$ В  
Заряд затвора: 195нКл  
Входная емкость: 13900пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18531Q5A

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А 8-Pin VSONP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 19А(Ta), 100А(Tc)  
Сопротивление открытого канала: 4.6 мОм @ 22А, 10В  
Мощность макс.: 3.1Вт

Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В @ 250  $\mu$ А  
Заряд затвора: 43нКл @ 10В  
Входная емкость: 3840пФ @ 30В  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18532KCS

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А TO220-3  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: TO-220  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 100А(Тс)  
Сопротивление открытого канала: 4.2 мОм @ 100А, 10В  
Мощность макс.: 216Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.2В @ 250  $\mu$ А  
Заряд затвора: 53нКл @ 10В  
Входная емкость: 4680пФ @ 30В  
Тип монтажа: Through Hole

#### CSD18533Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 60 В, 17 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 17А  
Сопротивление открытого канала: 5.9 мОм  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 36нКл  
Входная емкость: 2750пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18534Q5AT

Транзистор полевой N-канальный 60В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 13А  
Сопротивление открытого канала: 9.8 мОм  
Мощность макс.: 3.1Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 2.3В  
Заряд затвора: 22нКл  
Входная емкость: 1770пФ  
Тип монтажа: Surface Mount  
CSD18535KTTT  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 200А  
Мощность макс.: 300Вт  
Тип транзистора: N-канальный  
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18537NKCS  
Транзистор полевой N-канальный 60В 50А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: TO-220  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 50А  
Сопротивление открытого канала: 14 мОм  
Мощность макс.: 79Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.5В  
Заряд затвора: 18нКл  
Входная емкость: 1480пФ  
Тип монтажа: Through Hole

CSD18537NQ5A  
Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 50А VSONP-8  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-SON (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 11А(Т<sub>а</sub>), 50А(Т<sub>с</sub>)  
Сопротивление открытого канала: 13 мОм @ 12А, 10В  
Мощность макс.: 75Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.5В @ 250 μА  
Заряд затвора: 18нКл @ 10В  
Входная емкость: 1480пФ @ 30В  
Тип монтажа: Surface Mount

CSD18537NQ5AT  
Транзистор полевой N-канальный 60В 50А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 50А

Сопротивление открытого канала: 13 мОм  
Мощность макс.: 75Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.5В  
Заряд затвора: 18нКл  
Входная емкость: 1480пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18540Q5B

Транзистор полевой MOSFET N-канальный Si 60В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 100А  
Тип транзистора: N-канальный  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18540Q5B

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments

#### CSD18540Q5BT

Полевой транзистор N-канальный 60В 100А 8-Pin VSON-CLIP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 100А  
Тип транзистора: N-канал  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18541F5

Полевой транзистор N-канальный 60В 2.2А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments

#### CSD18543Q3A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 35А 8-Pin VSONP EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: VSONP-8 (3.3 mm x 3.3)  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 35А  
Тип транзистора: N-канал  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18563Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 60 В, 96 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: SON8EP

Напряжение исток-сток макс.: 60В

Ток стока макс.: 15А

Сопротивление открытого канала: 6.8 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 2.4В

Заряд затвора: 20нКл

Входная емкость: 1500пФ

Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD18563Q5AT

Полевой транзистор, N-канальный, 60 В, 100 А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: 8-VSON (5x6)

Напряжение исток-сток макс.: 60В

Ток стока макс.: 100А

Сопротивление открытого канала: 6.8 мОм

Мощность макс.: 3.2Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 2.4В

Заряд затвора: 20нКл

Входная емкость: 1500пФ

Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19531KCS

Транзистор полевой N-канальный 100В 100А

Производитель: Texas Instruments

Корпус: TO-220

Напряжение исток-сток макс.: 100В

Ток стока макс.: 100А

Сопротивление открытого канала: 7.7 мОм

Мощность макс.: 179Вт

Тип транзистора: N-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 3.3В

Заряд затвора: 38нКл

Входная емкость: 3870пФ

Тип монтажа: Through Hole

#### CSD19532Q5BT

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 100А

Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 100В  
Ток стока макс.: 100А  
Тип транзистора: N-канальный  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19533Q5A

Полевой транзистор, N-канальный, 100 В, 100 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP  
Напряжение исток-сток макс.: 100В  
Ток стока макс.: 100А  
Сопротивление открытого канала: 11.1 мОм  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В  
Заряд затвора: 35нКл  
Входная емкость: 2670пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19533Q5AT

Полевой транзистор, N-канальный, 100 В, 100 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON8EP

#### CSD19534Q5A

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 137А 8SON  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 100В  
Ток стока макс.: 50А(Ta)  
Сопротивление открытого канала: 15.1 мОм @ 10А, 10В  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В @ 250 μА  
Заряд затвора: 22нКл @ 10В  
Входная емкость: 1680пФ @ 50В  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19534Q5AT

Транзистор полевой MOSFET N-канальный 100В 137А 8SON  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON-FET (5x6)  
Напряжение исток-сток макс.: 100В

Ток стока макс.: 50A(Ta)  
Сопротивление открытого канала: 15.1 мОм @ 10A, 10V  
Мощность макс.: 3.2Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В @ 250 μА  
Заряд затвора: 22нКл @ 10V  
Входная емкость: 1680пФ @ 50V  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19535KCS

Транзистор полевой N-канальный 100V  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: TO-220  
Напряжение исток-сток макс.: 100V  
Ток стока макс.: 150A  
Сопротивление открытого канала: 3.6 мОм  
Мощность макс.: 300Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.4В  
Заряд затвора: 101нКл  
Входная емкость: 7930пФ  
Тип монтажа: Through Hole

#### CSD19535KTT

Полевой транзистор N-канальный 100V 200A 4-Pin(3+Tab) TO-263 лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 100V  
Ток стока макс.: 200A  
Тип транзистора: N-канал  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19535KTTT

Полевой транзистор N-канальный 100V 200A 4-Pin(3+Tab) TO-263 лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 100V  
Ток стока макс.: 200A  
Тип транзистора: N-канал  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD19536KCS

Транзистор полевой N-канальный 100V  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: TO-220  
Напряжение исток-сток макс.: 100V  
Ток стока макс.: 150A

Сопrotивление открытого канала: 2.7 мОм  
Мощность макс.: 375Вт  
Тип транзистора: N-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 3.2В  
Заряд затвора: 153нКл  
Входная емкость: 12000пФ  
Тип монтажа: Through Hole

#### CSD22205L

Транзистор полевой P-канальный 8В 7.4А 4-Pin PICOSTAR лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 8В  
Ток стока макс.: 7.4А  
Тип транзистора: P-канал

#### CSD23202W10

Транзистор полевой P-канальный 12В 2.2А 4DSBGA  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: DSBGA4  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 2.2А(Т<sub>а</sub>)  
Сопrotивление открытого канала: 53 мОм @ 500mA, 4.5В  
Мощность макс.: 1Вт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 900mВ @ 250 μА  
Заряд затвора: 3.8нКл @ 4.5В  
Входная емкость: 512пФ @ 6В  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD23203WT

Полевой транзистор P-канальный 8В 3А 6DSBGA  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 6-DSBGA  
Напряжение исток-сток макс.: 8В  
Ток стока макс.: 3А(Т<sub>а</sub>)  
Сопrotивление открытого канала: 19.4 мОм @ 1.5А, 4.5В  
Мощность макс.: 750мВт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В @ 250 μА  
Заряд затвора: 6.3нКл @ 4.5В  
Входная емкость: 914пФ @ 4В  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD23280F3T

Полевой транзистор P-канальный 12В 1.8А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 1.8А  
Тип транзистора: P-канал

#### CSD23285F5

Полевой транзистор P-канальный 12В 5.4А 3-Pin PicoStar  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 5.4А  
Тип транзистора: P-канал

#### CSD23381F4

Полевой транзистор P-канальный 12В 2.3А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 2.3А(Ta)  
Сопротивление открытого канала: 175 мОм @ 500mA, 4.5В  
Мощность макс.: 500мВт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.2В @ 250 μА  
Заряд затвора: 1.14нКл @ 4.5В  
Входная емкость: 236пФ @ 6В  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD25310Q2

Транзистор полевой P-канальный 20В 20А 6-Pin WSON EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON6  
Напряжение исток-сток макс.: 20В  
Ток стока макс.: 20А  
Сопротивление открытого канала: 23.9 мОм  
Мощность макс.: 2.9Вт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.1В  
Заряд затвора: 4.7нКл  
Входная емкость: 655пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD25402Q3A

Транзистор полевой MOSFET P-канальный 20В 72А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: VSONP-8 (3.3 mm x 3.3)

Напряжение исток-сток макс.: 20В  
Ток стока макс.: 72А  
Сопротивление открытого канала: 8.9 мОм  
Мощность макс.: 2.8Вт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.15В  
Заряд затвора: 9.7нКл  
Входная емкость: 1790пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD25481F4

Полевой транзистор P-канальный 20В 2.5А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3

#### CSD25481F4T

Полевой транзистор, P-канальный, 20 В, 2.5 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3

#### CSD25483F4

Полевой транзистор P-канальный 20В 1.6А 3-Pin PicoStar лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3  
Напряжение исток-сток макс.: 20В  
Ток стока макс.: 1.6А(Та)  
Сопротивление открытого канала: 205 мОм @ 500mA, 8В  
Мощность макс.: 500мВт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.2В @ 250 μА  
Заряд затвора: 0.959нКл @ 4.5В  
Входная емкость: 198пФ @ 10В

#### CSD25483F4T

Полевой транзистор, P-канальный, 20 В  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SON3  
Напряжение исток-сток макс.: 20В  
Ток стока макс.: 1.6А  
Сопротивление открытого канала: 205 мОм  
Мощность макс.: 500мВт  
Тип транзистора: P-канал  
Особенности: Logic Level Gate  
Пороговое напряжение включения макс.: 1.2В

Заряд затвора: 0.96нКл  
Входная емкость: 198пФ  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD83325L

Транзистор полевой N-канальный 12В 8А  
Производитель: Texas Instruments  
Напряжение исток-сток макс.: 12В  
Ток стока макс.: 8А  
Тип транзистора: N-канальный

#### CSD85301Q2

Транзистор полевой N-канальный 20В 5А 6-Pin WSON EP лента на катушке  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: WSON-6 (2x2)  
Напряжение исток-сток макс.: 20В  
Ток стока макс.: 5А  
Сопротивление открытого канала: 27 мОм @ 5А, 4.5В  
Мощность макс.: 2.3Вт  
Тип транзистора: N-канальный  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD88537NDT

Полевой транзистор, 2N-канальный, 60 В, 15 А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SOIC8  
Напряжение исток-сток макс.: 60В  
Ток стока макс.: 15А  
Тип транзистора: N-канал  
Тип монтажа: Surface Mount

#### CSD97395Q4MT

Драйвер управления затвором High Freq Sync Buck NexFETPw Stage  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: 8-VSON (3.5x4.5)  
Тип монтажа: Surface Mount

#### TPS1100D

Транзистор полевой P-канальный 15В 1.6А  
Производитель: Texas Instruments  
Корпус: SOIC8  
Напряжение исток-сток макс.: 15В  
Ток стока макс.: 1.6А  
Сопротивление открытого канала: 180 мОм  
Мощность макс.: 791мВт  
Тип транзистора: P-канал

Особенности: Logic Level Gate

Пороговое напряжение включения макс.: 1.5В

Заряд затвора: 5.45нКл

Тип монтажа: Surface Mount

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tax@nt-rt.ru](mailto:tax@nt-rt.ru) || сайт: <https://texas.nt-rt.ru>